

Рисунок 2 — Зависимость эффективности дифракции η от параметра отстройки частоты ультразвука \mathbf{f} от брэгговской $\Delta \mathbf{f}$ при различных значениях параметра заполнения $\Phi \mathbf{K}$ f: 1-0, 2-0,2, 3-0,5, 4-1 ($n_1=1,51,n_2=3,43$; 1=5 см, \mathbf{h} =1 мм, $\lambda=3$ мкм, $\mathcal{U}_g=7600$ м/с, $\mathbf{P_a}$ =10 Вт, $\mathbf{f_6}$ =81 МГц, α =10):

а). ТЕ-ТЕ-преобразование, б). ТМ-ТМ-преобразование)

Расчеты, представленные на рис. 2, показывают, что наибольшая полоса АО модуляции $\Delta f_{1/2}$ по уровню 3 дБ достигает для ТМ-ТМ- преобразования $\Delta f_{1/2} \approx 4.3$ МГц: для ТЕ-ТЕ- преобразования она составляет $\Delta f_{1/2} \approx 3.1$ МГц. Для светового пучка шириной w=5 см. Время прохода звукового пучка через апертуру светового пучка ($\tau=w/\upsilon$) составляет $\tau=6.5$ мкс. Разрешающая способность АО дефлектора $N=\Delta f_{1/2}\tau$. В случае дифракции при ТМ-ТМ- преобразовании разрешающая способность дефлектора составляет 28 (для $\tau=65$ мкс она составит N=280). Аналогично этому для ТЕ-ТЕ преобразования разрешающая способность составляет 20 (для $\tau=65$ мкс она составит N=200).

Список использованных источников

- 1. Белокопытов, Γ . В. Акустооптическая эффективность двумерных фотонных кристаллов / Γ . В. Белокопытов, 3. А. Пятакова // Письма в ЖТФ. 2011. Т. 37, В. 1. С. 3–10.
- 2. Балакший, В.Н. Физические основы акустооптики / В. Н. Балакший, В. Н. Парыгин, Л. Е. Чирков. М. : Радио и связь, 1985. 280 с.
- 3. Акустические кристаллы : справочник / А. А. Блистанов [и др.] ; под ред. М. П. Шаскольской. М. : Наука, 1986. 629 с.

УДК 534.8: 535.42

Γ . В. КУЛАК¹, П. И. РОПОТ², О. В. ШАКИН³

 1 УО «Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина» (г. Мозырь, Беларусь)

²ГНУ «Институт физики им. Б. И. Степанова Национальной академии наук Беларуси» (г. Минск, Беларусь)

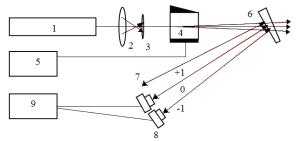
³ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (г. Санкт-Петербург, Россия)

НЕЛИНЕЙНЫЕ АКУСТООПТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СВЕТОВЫХ ПУЧКОВ В КРИСТАЛЛАХ КВАРЦА

В настоящее время значительный интерес исследователей и разработчиков представляет исследование особенностей преобразования и управления поляризационными и энергетическими параметрами световых пучков акустооптическими (АО) методами [1]. Установлено, что при дифракции света на медленной сдвиговой ультразвуковой (УЗ) волне в кристаллах парателлурита для излучения с длиной волны $\lambda = 1,06$ мкм при увеличении интенсивности света I_0 от $10~{\rm MBT/cm^2}~{\rm до}~240~{\rm MBT/cm^2}~{\rm эффективность}$ брэгтовской дифракции увеличивается в 1,7 раза [2].

В настоящей работе исследованы особенности брэгговской АО дифракции гауссовых и бесселевых интенсивных световых пучков в одноосных гиротропных кристаллах кварца.

На рисунке 1 представлена схема экспериментальной установки для исследования акустооптической (АО) дифракции мощных световых пучков на ультразвуке.



1 – импульсный лазер; 2,3 – сферические линзы; 4 – AO ячейка; 5 – генератор стабильного тока; 6 – клиновидная пластинка; 7,8 – пироэлектрические приемники; 9 – измеритель мощности

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки для исследования дифракции мощного лазерного излучения

Целью работы было экспериментальное исследование зависимости эффективности стоксовой и антистоксовой АО дифракции мощного лазерного излучения в кристаллах кварца от интенсивности света и удътразвука. АО ячейка была изготовлена из синтетического кварца высокого оптического качества размером $40 \times 10 \times 35$ мм³. Пьезопреобразователь обеспечивал резонансную частоту возбуждения 50 МГц. Длина АО взаимодействия составляла 40 мм. Верхняя часть звукопровода изготавливалась со скосом и имела дополнительно поглотитель звука. Пьезопреобразователь питался от генератора стабильного тока ГСТ-1, что наряду с конструкцией самой АО ячейки обеспечивало стабильность акустических параметров во времени. Температура звукопровода стабилизировалась термостатом.

В экспериментах использован импульсный твердотельный лазер на АИГ: Nc^{3+} (LS-2137 фирмы Lotis TII) с преобразованием длины волны, работающий в частотном режиме. Для удобства юстировки оптической схемы работа проводилась на второй гармонике ($\lambda = 532$ нм). Лазер генерировал импульсы длительностью 15 нс (по уровню 0,5) с частотой 1 Γ ц. Энергия импульса при максимальной накачке на длине волны 532 нм составляла 300 мДж. Диаметр пучка лазерного излучения на выходе составлял 9 мм при расходимости 0,5 мрад. Поляризация излучения – линейная.

Для получения высоких интенсивностей лазерный пучок фокусируется телескопической системой, образованной двумя сферическими линзами с фокусными расстояниями $f_1 = 300 \, \mathrm{cm}$ и $f_2 = -100 \, \mathrm{cm}$. Отрицательная линза применена для исключения точки фокусировки, где при пролете пыли в воздухе возникает пробой. Определение эффективности дифракции осуществлялось по отношению интенсивности первого «1» порядка дифракции к интенсивности прошедшего излучения в нулевой «0» порядок дифракции излучения. Измерение интенсивностей пучков при дифракции и их отношения проводилось двухканальным прибором Laserstar фирмы Ophir с двумя пироэлектрическими головками типа PE-25. На экран прибора выводилась интенсивность в каждом из каналов и их отношение (эффективность дифракции) в реальном масштабе времени. Прибором проводилось автоматическое усреднение по десяти импульсам. Для оценки погрешности измерений проводилась серия измерений. Результаты экспериментов приведены ниже на рис. 2 для гауссового пучка (ГП). Для оценки интенсивности пучка, дифрагировавшего на УЗ волне, при различных мощностях накачки лазера была измерена интенсивность пучка на выходе АО ячейки (с учетом потерь в оптической схеме на отражения от двух линз и передней грани АО ячейки) в отсутствии дифракции. Интенсивность лазерного пучка измерялась пьезоэлектрической головкой РЕ-50 ДИФ, а оценка диаметра пучка проводилась с помощью специальной фотобумаги.

На рис. 2 приведена зависимость эффективности дифракции $\eta = I_{1+}/I_0$, где индекс снизу — порядок дифракции. Графики приведены для трех различных интенсивностей УЗ волны I_a , причем $I_{a1} < I_{a2} < I_{a3}$. Точное значение акустической интенсивности определить не представлялось возможным из-за отсутствия необходимого оборудования.

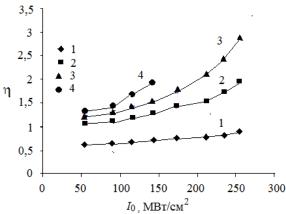


Рисунок 2 – Зависимость эффективности дифракции η от интенсивности лазерного пучка

При дифракции мощных бесселевых световых пучков (БСП), с использованием аксикона с углом при основании около одного градуса было получено только четыре точки (кривая 4) на невысоких интенсивностях света I_0 и при максимальной акустической мощности (соответствует акустической мощности график 3 на рисунке 2 для гауссового пучка). Измеренные четыре точки для БСП приведены на рис. 2 (кривая 4). Далее, при более высоких мощностях света, наблюдается повреждение аксикона, а в АО ячейке наблюдается нитевидный микроканал серого цвета и происходит заметное искажение лазерного пучка.

Список использованных источников

- 1. Поляризационно-независимая акустооптическая модуляция бесселевых световых пучков / В. Н. Белый [и др.] / Опт. и спектр. -2016. Т. 121, № 3. С. 458–465.
- 2. Проклов, В. В. Исследование дифракции мощного лазерного излучения в TeO_2 / В. В. Проклов [и др.] // Краткие сообщения по физике. Труды ФИАН. 1979. С. 1543–1545.

УДК 681.3

А. Е. ЛЮЛЬКИН

УО «Белорусский государственный университет» (г. Минск, Беларусь)

ПОСТРОЕНИЕ ТЕСТОВ ДЛЯ ЛОГИЧЕСКИХ КМОП-СХЕМ

Известно [1-2], что моделью константных неисправностей на уровне функциональных элементов либо невозможно непосредственно описать ряд физических дефектов, характерных для КМОЙ-схем, либо применение такой модели требует определенного искусства и приводит к преобразованию исходной схемы в значительно более сложную схему, т.е. неэффективно. Это ограничивает использование известных методов построения тестов, ориентированных на константные неисправности в схемах из функциональных элементов. В частности, в КМОП-схемах существуют неисправности типа обрыва транзистора, которые невозможно проверить одним входным набором, но можно проверить последовательностью из двух наборов T=(u, t). Входной набор t является проверяющим и переводит выход исправной схемы в определенное состояние 0 или 1, а выход схемы с неисправностью оказывается отключенным от источников сигналов, т.е. находится в состоянии высокого импеданса. Набор u используется для установки выхода схемы в состояние, противоположное определенному состоянию выхода, полученному на наборе t. Учитывая, что определенное значение сигнала на выходе схемы в состоянии отключения выхода от источников сигналов сохраняется в течение довольно длительного промежутка времени, достаточного для его контроля, последовательность T позволяет проверить неисправность.

К настоящему времени разработаны достаточно эффективные направленные методы построения тестовых последовательностей для неисправностей типа обрыва транзистора в полностью комплементарных схемах, включающих только p- и n-каскады [1,2]. В то же время представление всей логической КМОП-схемы на уровне транзисторов резко увеличивает размерности различных задач, которые необходимо решить в процессе построения теста. Указанную проблему можно преодолеть, используя иерархический подход к построению теста. Данный подход предполагает представление КМОП-схемы в целом на уровне функциональных элементов. В то же время при нахождении тестовых последовательностей для неисправностей типа обрыва транзистора в функциональных элементах используется их представление на переключательном уровне (уровень транзисторов). В этом случае возможно совместное использование методов построения тестовых последовательностей для неисправностей типа обрыва транзистора в функциональных элементах, представленных на переключательном уровне, и методов построения тестов для константных неисправностей в схемах, представленных на уровне функциональных элементов (в частности, широко распространенного *D*-алгоритма [3]). В настоящей работе понятие *D*-куба неисправности, используемое в *D*-алгоритме, распространяется на тестовые последовательности для неисправностей типа обрыва транзистора. Показывается возможность применения основных операций, используемых в *D*-алгоритме (операция расцирения фиксации, нахождение условий транспортировки неисправности к выходам схемы), для построения установочных и проверяющих наборов неисправностей типа обрыва транзистора. Исследуется возможность проверки неисправностей типа обрыва транзистора в функциональных элементах, представляющих собой полностью комплементарные МОП-схемы, тестами для константных неисправностей на входах и выходах таких элементов. На примере схем, построенных в базисе И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ, показывается возможность формирования теста для схемы в классе неисправностей типа обрыва транзистора из теста для константных неисправностей функциональных элементов. В заключение обсуждается задача минимизации длины построенного теста с использованием моделирования неисправностей и свойств тестовых последовательностей для неисправностей типа обрыва транзистора.

Построение проверяющих наборов для логических неисправностей с помощью D-алгоритма предполагает последовательное решение двух задач: 1) нахождение условий проявления неисправности в месте возникновения, т.е. поиск входного воздействия для функционального элемента, неисправность которого рассматривается, при котором выходная реакция элемента будет зависеть от наличия неисправности (D-куб неисправности); 2) нахождение условий транспортировки неисправности от места возникновения до одного из выходов схемы.